DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

18531711

Basic Patent (No,Kind,Date): US 20020187265 AA 20021212 <No. of Patents: 002> APPARATUS AND METHOD FOR MANUFACTURING AN ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE DISPLAY (English)

Patent Assignee: MORI TAKAO (JP); YAMAGUCHI MASARU (JP); KAMIYAMA ISAO (JP)

Author (Inventor): MORI TAKAO (JP); YAMAGUCHI MASARU (JP); KAMIYAMA ISAO (JP)

National Class: *427282000; 427066000; 427255600; 427255700; 427402000; 156345310; 118715000; 118720000

IPC: *B05D-005/06; B05D-005/12; C23C-016/00; B05D-001/32; B05D-001/36; C23F-001/00

CA Abstract No: 138(03)031115P Language of Document: English

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2002367781 A2 20021220 JP 2001177682 A 20010612

US 20020187265 AA 20021212 US 153453 A 20020521 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 2001177682 A 20010612

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 07499261

FILM-FORMING DEVICE AND FILM-FORMING METHOD

PUB. NO.:

2002-367781 [JP 2002367781 A]

PUBLISHED:

December 20, 2002 (20021220)

INVENTOR(s): MORI TAKAO

YAMAGUCHI MASARU

KAMIYAMA ISAO

APPLICANT(s): SONY CORP

APPL. NO.:

2001-177682 [JP 20011177682]

FILED:

June 12, 2001 (20010612)

INTL CLASS:

H05B-033/10; C23C-014/04; G09F-009/00; G09F-009/30;

H05B-033/12; H05B-033/14; H05B-033/22

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a film-forming device and a film-forming method with which a tact time of an organic layer forming process for an organic EL display equipment can be shortened and useless consumption of organic materials for formation of an organic layer can be curbed.

SOLUTION: The device is composed of an alignment room 53 where masks for film-forming with openings corresponding to a specified pattern are aligned with a substrate on which is formed an anode electrode layer and equipped with an alignment mechanism coupling the masks for film-forming with the substrate in free detachment, of vacuum processing rooms 62, 63, 64 where a plurality of organic material layers are sequentially formed on the substrate coupled with the masks for film-forming, and of a conveyance robot 45 which conveys the masks for film-forming and the substrate in a coupled state by the alignment mechanism to one of the vacuum processing rooms 62, 63, 64 and conveys them sequentially among the vacuum processing rooms 62, 63, 64.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-367781

(P2002-367781A) (43)公開日 平成14年12月20日(2002.12.20)

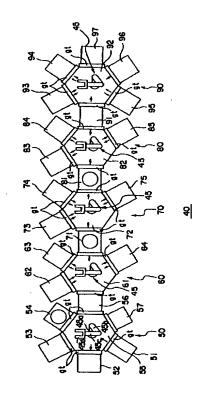
(51) Int. C1. 7 H05B 33/10 C23C 14/04	識別記号	F I H05B 33/10 C23C 14/04			テーマコート・ 3K007 4K029	(参考)
G09F 9/00	342	G09F 9/00	342	2	5C094	
9/30	338	9/30	338		5G435	
	365		365	Z		
	審	査請求 有 請求項の数19	OL	(全17	頁) 最終頁	に続く
(21)出願番号	特願2001-177682(P2001-177682 平成13年6月12日(2001.6.12)	ソニーを 東京都品 (72)発明者 森 敬息 東京都品 一株式会 (72)発明者 山口 を 東京都品	株式会社 品川区北 路川区北 会社内 曼 品川区北 会社内	品川67	丁目7番35号 丁目7番35号 丁目7番35号	
		(74)代理人 1000940 弁理士	53 佐藤	隆久	最終頁	に続く

(54) 【発明の名称】成膜装置および成膜方法

(57)【要約】

【課題】有機EL表示装置の有機層の形成工程のタクトタイムを短縮でき、かつ、有機層の形成に用いられる有機材料の無駄な消費を抑制することができる成膜装置および成膜方法を提供する。

【解決手段】所定のパターンに対応した開口をもつ成膜用マスクをアノード電極層が形成された基板に対してアライメントし、かつ、成膜用マスクと基板とを分離可能に結合させるアライメント機構を備えたアライメント室53と、成膜用マスクと結合された基板への複数の有機材料層の形成を順次行うための真空処理室62,63,64と、アライメント機構によって結合された状態にある成膜用マスクおよび基板を真空処理室62,63,64間で順次搬送する搬送ロボット45とを有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板と、前記基板上に複数形成された所定 パターンの第1の電極層と、前記各第1の電極層上に積 層された複数の有機材料層からなる所定パターンの有機 層と、前記有機層上に形成された第2の電極層とを有す る有機電界発光表示装置における少なくとも前記有機層 を形成する成膜方法であって、

前記所定のパターンに対応した開口をもつ成膜用マスク を前記第1の電極層が形成された基板に対してアライメ ントし、かつ、前記成膜用マスクと前記基板とを分離可 10 能に結合し、

前記成膜用マスクと結合された前記基板への前記複数の 有機材料層の形成を複数の真空処理室において順次行 い、かつ、当該真空処理室間を前記成膜用マスクと前記 基板とが結合された状態で搬送する成膜方法。

【請求項2】前記各有機材料層の形成をそれぞれ異なる 真空処理室で行う請求項1に記載の成膜方法。

【請求項3】前記各真空処理室において、前記各有機材 料層を形成する有機材料を供給する蒸着源をそれぞれ設 け、当該各真空処理室内に前記基板および成膜用マスク が搬入された際に当該各蒸着源から所定の蒸発レートで 有機材料を供給可能な状態にしておく請求項2に記載の 成膜方法。

【請求項4】前記真空処理室間は、真空搬送室で連結さ れており、前記成膜用マスクおよび前記基板の搬送を前 記真空搬送室を通じて行う請求項1に記載の成膜方法。

【請求項5】前記成膜用マスクは磁性体で形成されてお **9**,

前記基板と前記成膜用マスクとの結合をマグネットを用 いて行う請求項1に記載の成膜方法。

【請求項6】前記マグネットは、前記基板の非成膜面側 と全面的に接触する接触面を備える板状部材からなり、 前記成膜用マスクと前記マグネットとの間に前記基板を 挟み、前記成膜用マスクを吸着する前記マグネットの吸 着力により、当該成膜用マスクと基板とを結合させる請 求項5に記載の成膜方法。

【請求項7】前記有機層の形成後に、前記成膜用マスク と基板とを分離し、

前記有機層を被覆するように前記第2の電極層を形成す る請求項1に記載の成膜方法。

【請求項8】前記成膜用マスクと前記基板との結合およ び分離と、結合された前記成膜用マスクおよび基板の搬 送とを真空雰囲気下において行う請求項7に記載の成膜

【請求項9】前記有機電界発光表示装置は、前記基板上 にそれぞれ規則的に配列された発光色が異なる少なくと も第1および第2の有機層を備えており、

前記各有機層の形成に共通に使用可能な前記成膜用マス クと前記基板とを結合して前記第1の有機層を形成し、 前記第1の有機層を形成したのち、前記成膜用マスクと 50 おり、

前記基板とを分離し、両者のアライメントを変更し、か つ再び結合させて第2の有機層を形成する請求項1に記 載の成膜方法。

【請求項10】前記有機電界発光表示装置は、前記基板 上にそれぞれ規則的に配列された発光色が異なる第1, 第2および第3の有機層を備えており、

前記各有機層の形成に共通に使用可能な成膜用マスクと 前記基板とを結合して前記第1の有機層を形成し、

前記第1の有機層を形成したのち、前記成膜用マスクと 前記基板とを分離し、両者のアライメントを変更し、か つ再び結合させて第2の有機層を形成し、

前記第2の有機層を形成したのち、前記成膜用マスクと 前記基板とを分離し、両者のアライメントを変更し、か つ再び結合させて第3の有機層を形成し、

前記第3の有機層を形成したのち、前記成膜用マスクと 前記基板とを分離し、真空処理室内において前記第3の 有機層を被覆するように前記第2の電極層を形成する請 求項9に記載の成膜方法。

【請求項11】基板と、前記基板上に複数形成された所 定パターンの第1の電極層と、前記各第1の電極層上に 積層された複数の有機材料層からなる所定パターンの有 機層と、前記有機層上に形成された第2の電極層とを有 する有機電界発光表示装置における少なくとも前記有機 層を形成する成膜装置であって、

前記所定のパターンに対応した開口をもつ成膜用マスク を前記第1の電極層が形成された基板に対してアライメ ントし、かつ、前記成膜用マスクと前記基板とを分離可 能に結合させるアライメント機構と、

前記成膜用マスクと結合された前記基板への前記複数の 30 有機材料層の形成を順次行うための複数の真空処理室 と、

結合された状態にある前記成膜用マスクおよび基板を前 記複数の真空処理室のうちの一つへ搬送し、かつ、当該 複数の真空処理室間で順次搬送する搬送手段とを有する 成膜装置。

【請求項12】前記複数の真空処理室は、それぞれ前記 各有機材料層の形成を一層のみ行う請求項11に記載の 成膜装置。

【請求項13】前記各真空処理室は、前記各有機材料層 40 を形成する有機材料を供給する蒸着源を備えている請求 項11に記載の成膜装置。

【請求項14】前記真空処理室間を連結する真空搬送室 をさらに有し、

前記搬送手段は、前記真空搬送室内に設置されている請 求項11に記載の成膜装置。

【請求項15】前記基板と前記成膜用マスクとを結合す る結合治具をさらに有する請求項11に記載の成膜装 置。

【請求項16】前記成膜用マスクは磁性体で形成されて

前記結合治具は、前記基板の非成膜面側と全面的に接触する接触面を備え、少なくとも当該接触面が板状のマグネットで形成されており、前記成膜用マスクと前記接触面との間に挟まれた前記基板を、前記成膜用マスクを吸着する前記マグネットの吸着力により、当該成膜用マスクと基板とを結合する請求項15に記載の成膜装置。

【請求項17】前記有機電界発光表示装置は、前記基板上にそれぞれ規則的に配列された発光色が異なる少なくとも第1および第2の有機層を備えており、

前記各有機層の形成に共通に使用可能な成膜用マスクを 10 前記第1の電極層が形成された基板に対してアライメントし、かつ、当該成膜用マスクと前記基板とを分離可能に結合させる第1のアライメント機構と、

前記成膜用マスクと結合された前記基板への前記有機層 の形成を順次行うための複数の第1の真空処理室と、

前記第1の有機層が形成された基板と前記成膜用マスクとを分離し、両者のアライメントを前記第2の有機層を 形成する位置に変更し、かつ再び分離可能に結合させる 第2のアライメント機構と、

前記成膜用マスクと再び結合された前記基板への前記第 2の有機層の形成を順次行うための複数の第2の真空処 理室とを有する請求項11に記載の成膜装置。

【請求項18】前記有機電界発光表示装置は、前記基板上にそれぞれ規則的に配列された発光色が異なる第1,第2および第3の有機層を備えており、

前記各有機層の形成に共通に使用可能な成膜用マスクを 前記第1の電極層が形成された基板に対してアライメン トし、かつ、当該成膜用マスクと前記基板とを分離可能 に結合させる第1のアライメント機構と、

前記成膜用マスクと結合された前記基板への前記有機層 の形成を順次行うための複数の第1の真空処理室と、

前記第1の有機層が形成された基板と前記成膜用マスクとを分離し、両者のアライメントを前記第2の有機層を 形成する位置に変更し、かつ再び分離可能に結合させる 第2のアライメント機構と、

前記成膜用マスクと再び結合された前記基板への前記第2の有機層の形成を順次行うための複数の第2の真空処理室と.

前記第2の有機層が形成された基板と前記成膜用マスクとを分離し、両者のアライメントを前記第3の有機層を 40 形成する位置に変更し、かつ再び分離可能に結合させる第3のアライメント機構と、

前記成膜用マスクと再び結合された前記基板への前記第3の有機層の形成を順次行うための複数の第3の真空処理室と、

前記第3の有機層を形成したのち、前記成膜用マスクと 前記基板とを分離する分離機構と、

前記成膜用マスクと分離された前記基板に前記第3の有機層を被覆するように前記第2の電極層を形成するための真空処理室とを有する請求項11に記載の成膜装置。

【請求項19】前記第1,第2および第3のアライメント機構は、前記成膜用マスクを支持可能なマスク支持部材と、

前記基板を支持可能な基板支持部材と、

前記結合治具を支持可能な結合治具支持部材と、

前記各支持部材の相対位置を変更する移動機構と、を有し、

前記各支持部材間の相対位置の変更によって、前記成膜 用マスクと基板とのアライメントおよび前記成膜用マス クと基板と結合治具との結合および/または分離を行う 請求項18に記載の成膜装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 (以下、有機EL(electro luminescence)素子とい う。)を用いた表示装置における有機層を成膜するのに 好適な成膜装置および成膜方法に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、有機材料からなる有機層を陽極および陰極からなる電極間に挟み込む構造をもつ。この電極間に電圧を印加すると、有機EL素子の有機層には、陰極から電子が注入され、陽極から正孔が注入され、これらの電子と正孔が再結合し発光が生じることが知られている。このような有機EL素子は、10ボルト以下の駆動電圧で、たとえば、数百~数万cd/m²の輝度が得られる。また、有機EL素子は、発光材料である蛍光物質を適宜選択することにより適当な色彩に発光させることができる。これらのことから、有機EL素子を用いた表示装置は、CRT(cathode ray tube)に代わるマルチカラーまたはフルカラーの表示装置として有望視されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述した有機層は、たとえば、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電荷注入層等の3~5層の有機材料層を積層したものが一般的である。各有機材料層は処理室内で有機材料を蒸着させることにより形成される。従来における成膜方法においては、各有機材料層の蒸着は、同一の処理室内で行っていた。具体的には、処理室内に設けられた表示装置の各直素に対応して開口する成膜用マスクを処理室内に搬入された基板に対してアライメントしたのち、各有機材料層に対応して処理室内に設けられた複数の加熱容器にそれぞれ異なる蒸着材料を収容しこれらを加熱して蒸発させることにより行われる。

【0004】しかしながら、上記のように、同一の処理室内で複数の有機材料層からなる有機層の形成を行うと、有機層の形成工程のタクトタイムが非常に長くなり、有機EL素子を用いた表示装置の量産化が困難であるという不利益が存在した。すなわち、同一の処理室内で複数の有機材料層からなる有機層の形成を行った場合

には、各蒸着材料を蒸着毎に加熱する必要があり、所望の温度に達するまでに比較的長時間を要し、さらに、蒸着源の蒸発レートが安定化するまでに比較的長時間を要するため、各有機材料層の蒸着を開始する前の待ち時間が長時間化し、結果として、有機層の形成に要する時間が非常に長くかかる。一方、蒸着材料を常時所定の温度まで加熱して蒸発レートを安定化しておくことにより、各有機材料層の蒸着を開始する前の待ち時間を短縮化することができる。しかしながら、一の蒸着源を用いて対応する有機材料層を蒸着中においては、他の蒸着源からも蒸着材料が蒸発するため、無駄な材料の消費が避けられない。有機EL素子に用いられる有機材料は非常に高価であるため、有機層の製造コストが嵩み、結果として有機EL素子を用いた表示装置の量産化が困難となる。

【0005】同一の処理室内で有機層を形成することによる不利益を解消するための技術が、たとえば、特開平8-111285号公報に開示されている。上記の刊行物は、各有機材料層毎に蒸着のための処理室を真空層を中心に設け、各処理室間での基板の搬送を真空層を通じて行う技術を開示している。各有機材料層の蒸着を異なる処理室に分散化することにより、蒸着源の加熱および蒸着レートの安定化のための待ち時間を大幅に短縮化できる。しかしながら、各有機材料層の蒸着を異なる処理室に分散化すると、各処理室毎に基板とマスクとのアライメント作業が必要である。このため、有機層の形成工程のタクトタイムを充分に短縮することができない。また、アライメント作業が行われている間は、蒸着材料は無駄に消費されてしまう。

【0006】本発明は、上述の問題に鑑みて成されたものであって、有機EL表示装置の有機層の形成工程のタ 30クトタイムを短縮でき、かつ、有機層の形成に用いられる有機材料の無駄な消費を抑制することができる成膜装置および成膜方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の成膜方法は、基板と、前記基板上に複数形成された所定パターンの第1の電極層と、前記各第1の電極層上に積層された複数の有機材料層からなる所定パターンの有機層と、前記有機層上に形成された第2の電極層とを有する有機電界発光表示装置における少なくとも前記有機層を形成する成膜 40方法であって、前記所定のパターンに対応した開口をもつ成膜用マスクを前記第1の電極層が形成された基板に対してアライメントし、かつ、前記成膜用マスクと前記基板との前記成膜用マスクと結合された前記基板への前記複数の有機材料層の形成を複数の真空処理室において順次行い、かつ、当該真空処理室間を前記成膜用マスクと前記基板とが結合された状態で搬送する。

【0008】好適には、前記各有機材料層の形成をそれぞれ異なる真空処理室で行う。

【0009】さらに好適には、前記各真空処理室において、前記各有機材料層を形成する有機材料を供給する蒸着源をそれぞれ設け、当該各真空処理室内に前記基板および成膜用マスクが搬入された際に当該各蒸着源から所定の蒸発レートで有機材料を供給可能な状態にしておく。

【0010】本発明の成膜装置は、基板と、前記基板上に複数形成された所定パターンの第1の電極層と、前記各第1の電極層上に積層された複数の有機材料層からなる所定パターンの有機層と、前記有機層上に形成された第2の電極層とを有する有機電界発光表示装置における少なくとも前記有機層を形成する成膜装置であって、クを前記第1の電極層が形成された基板に対してアライメントし、かつ、前記成膜用マスクと前記基板とを分離に結合させるアライメント機構と、前記成膜用マスクを結合された前記基板への前記複数の有機材料層の形成を傾次行うための複数の真空処理室と、結合された状態にある前記成膜用マスクおよび基板を前記複数の真空処理室のうちの一つへ搬送し、かつ、当該複数の真空処理室のうちの一つへ搬送し、かつ、当該複数の真空処理室間で順次搬送する搬送手段とを有する。

【0011】本発明では、成膜用マスクと基板とがアラ イメントされ、かつ結合されると、両者が結合された状 態で複数の真空処理装置の一つに搬入される。この成膜 用マスクと基板とが搬入された真空処理装置は、有機層 を構成する複数の有機材料層の少なくとも一層を形成可 能な状態となっており、搬入が完了すると有機材料層が 形成される。有機材料層の少なくとも一層が形成された のち、成膜用マスクと基板とは結合された状態で搬出さ れ、他の真空処理装置に搬入され、さらなる有機材料層 が積層される。同様な有機材料層の形成および成膜用マ スクおよび基板の搬送が有機層が形成されるまで繰り返 し行われる。このように、本発明では、有機層を構成す る複数の有機材料層の形成を複数の真空処理装置で分担 して行うとともに、複数の真空処理装置間の基板の搬送 を成膜用マスクと基板とが結合された状態で行う。この ため、各真空処理装置間において成膜用マスクと基板と のアライメントを行う必要がなく、アライメントに要す る時間を省略できる。

0 [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図1および図2は、本発明が適用される有機EL表示装置の一例を示す図であって、図1は当該有機EL表示装置の表示エリアの概略構成を示す要部断面図であり、図2は要部平面図である。なお、図1は図2のA-A、線方向の断面図である。また、図1および図2に示す有機EL表示装置は、いわゆるアクティブマトリックス型のカラー表示装置である。【0013】図1に示す表示装置は、基板1と、基板1上に形成された複数の薄膜トランジスタ2と、層間絶縁

膜7を介して各薄膜トランジスタ2上に形成されたアノ ード電極10と、各アノード電極10上に形成された発 光色がそれぞれ緑(G)、赤(R)、青(B)の有機層 11G, 11R, 11Bと、有機層11G, 11R, 1 1 B上に形成されたカソード電極 1 2 と、カソード電極 12上に形成された透明導電膜16と、透明導電膜16 に上に紫外線硬化樹脂層17を介して固着された基板1 8とを有する。なお、アノード電極10、有機層11 G, 11R, 11Bおよびカソード電極12によって各 発光色を自ら発光する有機EL素子が構成されており、 これら有機EL素子および各薄膜トランジスタ2によっ て各画素aが構成される。各有機EL素子の有機層11 G, 11R, 11Bで発光した光はカソード電極12側 を透過して基板18を通じて出射される。また、各画素 aは、図2に示すように、マトリックス状に配列されて いるとともに、有機層11G,11R,11Bはそれぞ れ規則的な順序で配列されている。

【0014】基板1は、絶縁性の材料から形成されてい る。たとえば、ガラス基板のような硬質部材やポリアミ ドフィルム等のプラスチック基板のような可撓性部材が 20 用いられる。なお、上記した有機EL素子の発光した光 の透過方向がカソード電極12側であるので、基板1は 透明材料でなくてもよい。

【0015】薄膜トランジスタ2では、基板1上にゲー ト電極3が所定パターンで形成され、このゲート電極3 の上にゲート絶縁膜5を介してポリシリコン層20が形 成され、さらに、このポリシリコン層20を被覆するよ うに層間絶縁膜4が形成されている。また、ゲート電極 3の側方のゲート絶縁膜5上には、ソース領域21およ びドレイン領域22が形成され、当該ソース領域21お 30 よびドレイン領域22は、層間絶縁膜4に形成された図 示しない接続孔を通じて配線6が電気的に接続されてい る。この配線6を被覆するように層間絶縁膜7が形成さ れている。

【0016】アノード電極10は、層間絶縁膜7上に各 画素 a に対応して形成されている。このアノード電極 1 0は、層間絶縁膜7の配線6上に形成された接続孔8を 通じて配線6と電気的に接続されている。アノード電極 10の形成材料としては、たとえば、クロム (С r)、 鉄 (Fe)、コバルト (Co)、ニッケル (Ni)、銅 40 (Cu)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、プ ラチナ (Pt)、金 (Au) 等のように仕事関数が大き く、かつ、反射率の高い導電性材料が用いられる。

【0017】アノード電極10上には、有機層11G, 11R、11Bが形成されているとともに、アノード電 極10の周縁部を被覆し、かつ、有機層11G,11 R, 11Bの周囲を包囲するように絶縁膜13が形成さ れている。絶縁膜13は、たとえば、酸化シリコンで形 成されている。

れている。リプ14は、図2に示すように、各画素 a間 に行列状に配置されており、側壁が順テーパ形状に形成 されている。リプ14は、有機層11G,11R,11 Bをアノード電極10上に蒸着形成する際に用いられる 成膜用マスクのスペーサとして機能する。すなわち、成 膜用マスクとアノード電極10との距離を規定する役割 を果たす。また、リブ14は、絶縁膜13から突出した 絶縁性材料層14aと、この絶縁性材料層14aの頂部 に形成された導電性材料層14 bとから構成されてい 10 る。絶縁性材料層14aは、たとえば、ポリイミド等の 有機絶縁材料や、酸化シリコンのような無機絶縁材料で 形成される。導電性材料層14bはカソード電極12に 接続された補助電極であり、アルミニウム (A1) やク ロム (Cr) のような比較的低抵抗の導電性材料で形成 されている。

【0019】図3は、有機層11G、11R, 11Bの 構造の一例を示す断面図である。図3に示すように、有 機層11G、11R、11Bは、たとえば、アノード電 極10の上に形成された正孔注入層11aと、この正孔 注入層11aの上に積層された正孔輸送層11bと、正 孔輸送層11bの上に積層された電子輸送層を兼ねる発 光層11cから構成される。発光層11cは、カソード 電極12によって被覆されている。

【0020】正孔注入層11a、正孔輸送層11bおよ び発光層11cは、それぞれ発光色に応じた有機材料を 蒸着によって所定の膜厚に形成される。正孔注入層 1 1 aの有機材料としては、たとえば、m-MTDATA [4, 4, 4媒-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenyla mine] 等が用いられる。正孔注入層11aの厚さは、た とえば、30 nm程度である。正孔輸送層11 bの有機 材料としては、たとえば、α-NPD[4,4-bis(N-1-nap hthyl-N-phenylamino)biphenyl] 等が用いられる。正孔 輸送層11bの厚さは、たとえば、20nm程度であ る。発光層11cの有機材料としては、たとえば、A1 q 3 [tris(8-quinolinolato)aluminium(III)] 等が用い られる。発光層11cの厚さは、たとえば、50nm程 度である。

【0021】カソード電極12は、各画素 a に共通に形 成されており、リブ14の表面を被覆し、リブ14の頂 部を構成する導電性材料層14bと接続されている。ま た、カソード電極12は、有機層11G、11R,11 Bおよび絶縁膜13によってアノード電極10と絶縁さ れている。このカソード電極12は、たとえば、マグネ シウム(Mg)-銀(Ag)合金等の仕事関数が小さく 透過率の高い金属薄膜が共蒸着によって所定の膜厚に形 成される。カソード電極12の厚さは、たとえば、10 nm程度である。

【0022】透明導電膜16は、カソード電極12を被 覆するように形成されている。この透明導電膜16は、 【 $0\ 0\ 1\ 8$ 】 この絶縁膜 $1\ 3$ 上には、リブ $1\ 4$ が形成さ 50 たとえば、スパッタリングによって所定の厚さに形成さ

れる。形成材料としては、たとえば、常温における成膜 によって良好な導電性を示すインジウム (In) - 亜鉛 (Zn)-酸素(O)系の材料等を用いることができ る。透明導電膜16の厚さは、たとえば、200nm程 度である。

【0023】基板18は、透明な材料で形成される。有 機層11G、11R, 11Bの発光層11cから発光さ れ、透明導電膜16を通じて入射する光を透過させるた めにある。たとえば、ガラス基板のような硬質部材やポ 部材が用いられる。

【0024】図4は、本発明の一実施形態に係る成膜装 置の構成を示す図である。図4に示す成膜装置40は、 上記した有機層11G、11R、11B、カソード電極 12および透明導電膜16を形成する。図4に示すよう に、成膜装置40は、搬入部50と、緑有機層形成部6 0と、赤有機層形成部70と、青有機層形成部80と、 電極形成部90とから構成される。

【0025】搬入部50は、基板搬入室51と、前処理 室52と、マスク搬入室53と、アライメント室54 と、搬送作業室55と、搬送室56と、治具搬入室57 とを有する。基板搬入室51、前処理室52、マスク搬 入室53、アライメント室54、搬送作業室55、治具 搬入室57および搬送室56は、内部を排気して実質的 に真空雰囲気にすることが可能な真空室で構成されてい る。また、基板搬入室51、前処理室52、マスク搬入 室53、アライメント室54、治具搬入室57および搬 送室56は、搬送作業室55の周囲にゲートgtを介し て連結されている。ゲートg t は、図示しないゲートバ ルブによって開閉される。また、これらのゲートバルブ 30 は、搬送ロボット45の動作に応じて開閉が行われるよ うに制御される。

【0026】基板搬入室51は、有機層11G、11 R, 11B、カソード電極12および透明導電膜16を 形成すべき基板1が搬入される。基板搬入室51は、い わゆるロードロックチャンバである。図5は、基板搬入 室51に搬入される基板1の構成を示す要部断面図であ る。図5に示すように、基板1上には、スペーサとして 機能するリブ14が突出した状態となっている。また、 リプ14で囲まれたアノード電極10は表面に露出した 40 状態となっている。

【0027】前処理室52は、図5に示した状態の基板 1のアノード電極10やリブ14の表面処理を行う。た とえば、基板1の表面に酸素プラズマ処理を施す。ま た、UVオゾン処理等でも構わない。

【0028】マスク搬入室53は、基板1に対してアラ イメントされ、かつ結合され(一体化される)成膜用マ スクが搬入される。マスク搬入室53はいわゆるロード ロックチャンパである。図6は、成膜用マスクおよびこ

の一例を示す斜視図である。図6に示すように、成膜用 マスク200は、矩形状の外形を有する板状の部材から なり、成膜用マスク200の形成材料は、鉄、ニッケル 等の磁性体で形成されている。この成膜用マスク200 は、基板1よりも大きな寸法を有し、外枠部202で囲 まれたマスク部201には、上記した有機層11R,1 1G, 11Bのパターンに対応した複数の開口が形成さ れており、成膜用マスク200は有機層11R,11 G, 11Bの形成に共通に使用可能となっている。すな リアミドフィルム等のプラスチック基板のような可撓性 10 わち、有機層11R,11G,11Bは、基板1上にそ れぞれ規則的に配列されていることから、基板1と成膜 用マスク200とのアライメントを調整することによ り、成膜用マスク200の開口を基板1の有機層11 R, 11G, 11Bの形成位置にそれぞれ合わせること ができる。

> 【0029】結合治具100は、基板1の外形と略同じ 寸法をもつマグネットプレート部101と、このマグネ ットプレート部101の両端部に連結された把手部10 2とを有する。把手部102は、マグネットプレート部 101の両端部から一部が側方に突出するように伸びて おり、この把手部102が後述する搬送ロボットのアー ム等により保持される。マグネットプレート部101 は、磁力によって成膜用マスク200を吸着可能となっ ている。図6において、マグネットプレート部101の 基板1の非成膜面1 a側に対向する面は、基板1の非成 膜面1 aに全面的に接触する接触面101 aとなってい

> 【0030】基板1と成形用マスク200との結合(一 体化)は、基板1の成膜面1bを成形用マスク200に 対向させ両者をアライメントした状態でマグネットプレ ート部101の接触面101aを基板1の非成膜面1a に接触させることにより行われる。マグネットプレート 部101の接触面101aを基板1の非成膜面1aに接 触させると、磁性体からなる成形用マスク200は、基 板1を介してマグネットプレート部101に吸着され る。また、成形用マスク200のマスク部201は、磁 力によって基板1の成膜面1bに引きつけられ、マスク 部201に弛みが発生しない。

【0031】治具搬入室57は、上記した結合治具10 0が搬入される。治具搬入室57は、ロードロックチャ ンパである。

【0032】搬送作業室55は、内部に搬送ロボット4 5を備えている。この搬送ロボット45は、水平方向に 旋回可能に連結された複数のアーム45a,45b,4 5 c を備えている。また、アーム45 a の先端部には、 上記の基板1、成形用マスク200および結合治具10 0を保持可能な保持部45dを備えている。また、搬送 ロボット45は、複数のアーム45a, 45b, 45c を鉛直方向に昇降可能な構造を有する。この搬送ロボッ の成膜用マスクと基板 1 とを結合させる結合治具の構造 50 ト 4 5 を制御することにより、基板 1 、成形用マスク 2

00および結合治具100の搬送を行う。

【0033】アライメント室54は、上記した基板1と成形用マスク200とのアライメントおよび結合治具100を用いた基板1と成形用マスク200との結合を行うためのアライメント機構を備えている。図7は、アライメント室54の構造を示す図である。なお、後述するアライメント室71および81と基板/マスク分離室93も図7に示すアライメント機構と同様のアライメント機構を有する。

【0034】図7に示すように、アライメント室54 は、隔壁300内の上部に設置された治具ホルダ310 と、この治具ホルダ310の下方に設置された基板ホル ダ314と、基板ホルダ314の両側に設置されたマス クホルダ320とを備える。

【0035】治具ホルダ310は、下端部に保持部310aを備えており、この保持部310aにより結合治具100の把手部102を保持する。この治具ホルダ310は、連結ロッド311を介して、隔壁300の外側上部に設けられた昇降機構330と連結されている。この昇降機構330は、鉛直方向(Z方向)に治具ホルダ32010を昇降させる。この昇降機構330は、たとえば、サーボモータ、伝達機構等から構成される。

【0036】基板ホルダ314は、回転軸317に連結された連結部材315と、この連結部材315の両端部に立設された複数の支持部316を備えており、支持部316の先端部により基板1の成膜面1bの周辺部を支持可能となっている。なお、この支持部316は、図6に示した成膜用マスク200のマスク部201の四隅に形成された貫通孔202aに挿入される。

【0037】基板ホルダ314に連結された回転軸317は、隔壁300内の下部の外側に設置された移動回転機構340に接続されている。この移動回転機構340は、基板ホルダ314を回転軸317を中心とする回転方向6に回転可能に保持し、また、2方向およびこの2方向に直交するX方向およびY方向に基板ホルダ314を移動可能に保持している。移動回転機構340は、たとえば、サーボモータ、伝達機構等から構成される。

【0038】マスクホルダ320は、上記の成膜用マスク200の下面の両端部を支持可能となっており、各マスクホルダ320は連結ロッド321を介して昇降機構 40350に接続されている。昇降機構350は、マスクホルダ320をZ方向に昇降可能保持している。なお、昇降機構350は、図7において、分離して記載されているが、実際には一体の機構であり、各マスクホルダ320を同時に昇降させる。

【0039】搬送室56は、アライメント室54において結合治具100によって結合された状態の基板1および成膜用マスク200を緑有機層形成部60に搬入するための搬入路を構成している。

【0040】緑有機層形成部60は、有機層11Gの形 50 導コイル421に供給することにより、誘導コイル42

成を行う。この緑有機層形成部60は、搬送作業室61 と、複数の蒸着処理室62,63および64とを有する。搬送作業室61と蒸着処理室62,63および64 は、内部を排気して実質的に真空雰囲気にすることが可能な真空室で構成されている。また、蒸着処理室62,63および64は、搬送作業室61の周囲にゲートg tを介して連結されている。

12

【0041】搬送作業室61内には、上記構成の搬送ロボット45が設置されている。この搬送ロボット45に 10 より、各蒸着処理室62,63および64間および赤有機層形成部70への基板1および成膜用マスク200の搬送が行われる。

【0042】蒸着処理室62は、有機層11Gの正孔注入層11aの形成を行う。蒸着処理室63は、有機層11Gの正孔輸送層11bの形成を行う。蒸着処理室64は、有機層11Gの発光層11cの形成を行う。

【0043】図8は、各蒸着処理室62,63および64の構成の一例を示す断面図である。なお、後述する赤有機層形成部70における蒸着処理室73,74および75と青有機層形成部80の蒸着処理室83,84および85も図8に示す構成と基本的に同一の構成となっている。

【0044】図8に示すように、隔壁400内の上方には、基板1および成膜用マスク200を結合する結合治具100を保持可能な治具ホルダ401が設置されている。この治具ホルダ401は、結合治具100の把手部102を保持する保持部401aを下端部に備えている。また、治具ホルダ401は、回転軸402と連結されており、回転軸402は隔壁400の外側の上部に設置された回転機構430と接続されている。

【0045】回転機構430は、蒸着の際に、回転軸402を所定の回転数で回転させる。回転機構430は、たとえば、サーボモータおよび伝達機構等から構成される。回転機構430によって回転軸402が回転されると、治具ホルダ401に保持された基板1および成膜用マスク200も回転軸402を中心に回転する。

【0046】隔壁400の下部には、上記した有機材料からなる蒸着材料Vsを内部に収容する加熱容器420が設置されている。この加熱容器420は、上端側に開口部420aを備えており、この開口部420aの上に当該開口部420aを開閉するシャッター440が設置されている。シャッター440は、図示しない移動機構により、開閉方向C1およびC2方向に駆動される。このシャッター440は、蒸着を行わないときに、開口部420aを閉じることにより、無駄な有機材料の消費を防ぐために設けられている。

【0047】加熱容器420には、誘導コイル421が 内蔵されており、この誘導コイル421は交流電源42 2と接続されている。交流電源422から交流電流を誘 第コイル421に供給することにより、誘導コイル42

1の発生する電磁界によって加熱容器420自体が加熱される。これにより、加熱容器420内に収容された蒸着材料Vsが蒸発する。なお、交流電源422は、供給電流を調整することによって、加熱容器420の温度を制御可能となっている。

【0048】赤有機層形成部70は、有機層11Rの形成を行う。この赤有機層形成部70は、アライメント室71と、搬送作業室72と、複数の蒸着処理室73,74および75とを有する。搬送作業室72と蒸着処理室73,74および75は、内部を排気して実質的に真空10雰囲気にすることが可能な真空室で構成されている。また、蒸着処理室73,74および75は搬送作業室72の周囲にゲートgtを介して連結されている。

【0049】アライメント室71は、搬入部50のアライメント室54と同様のアライメント機構を有する。このアライメント室71は、アライメント室54において結合された基板1と成膜用マスク200とを一旦分離し、有機層11Rの形成を行う位置に基板1と成膜用マスク200とをアライメントし直し、結合治具100で基板1と成膜用マスク200とを再び結合させる。

【0050】搬送作業室72内には、上記構成の搬送ロボット45が設置されている。この搬送ロボット45により、各蒸着処理室73,74および75間および青有機層形成部80への基板1および成膜用マスク200の搬送が行われる。

【0051】蒸着処理室73は、有機層11Rの正孔注入層11aの形成を行う。蒸着処理室74は、有機層11Rの正孔輸送層11bの形成を行う。蒸着処理室75は、有機層11Rの発光層11cの形成を行う。

【0052】青有機層形成部80は、有機層11Bの形成を行う。この青有機層形成部80は、アライメント室81と、搬送作業室82と、複数の蒸着処理室83,84および85とを有する。

【0053】アライメント室81は、赤有機層形成部70のアライメント室71と同様のアライメント機構を有する。このアライメント室81は、アライメント室71において結合された基板1と成膜用マスク200とを一旦分離し、有機層11Bの形成を行う位置に基板1と成膜用マスク200とをアライメントし直し、結合治具100で基板1と成膜用マスク200とを再び結合させる。

【0054】搬送作業室82内には、上記構成の搬送ロボット45が設置されている。この搬送ロボット45により、各蒸着処理室83,84および85間および電極形成部90への基板1および成膜用マスク200の搬送が行われる。

【0055】蒸着処理室83は、有機層11Bの正孔注 入層11aの形成を行う。蒸着処理室84は、有機層1 1Bの正孔輸送層11bの形成を行う。蒸着処理室85 は、有機層11Bの発光層11cの形成を行う。 【0056】電極形成部90は、搬入室91と、搬送作業室92と、基板/マスク分離室93と、電極形成室94と、スパッタ室95と、基板搬出室96と、治具/マスク搬出室97と有する。搬入室91、搬送作業室92、基板/マスク分離室93、電極形成室94、スパッタ室95、基板搬出室96および治具/マスク搬出室97は、内部を排気して実質的に真空雰囲気にすることが可能な真空室で構成されている。また、搬入室91、基板/マスク分離室93、電極形成室94、スパッタ室95、基板搬出室96および治具/マスク搬出室97は搬送作業室92の周囲にゲートgtを介して連結されている。

【0057】搬入室91は、青有機層形成部80において有機層11Bの形成が行われた後の基板1および成膜用マスク200を搬送作業室92に搬入するための搬送路を構成している。

【0058】基板/マスク分離室93は、上記のアライメント室54,71および81と同様のアライメント機構を有する。この基板/マスク分離室93は、アライメント機構によって結合治具100によって結合された状態にある基板1と成膜用マスク200とを分離する。

【0059】電極形成室94には、成膜用マスク200と分離された後の基板1に上記のカソード電極12を形成するための蒸着装置が設けられている。なお、この蒸着装置は、周知の蒸着装置であり、詳細説明を省略する。

【0060】スパッタ室95は、カソード電極12が形成された後の基板1に、上記の透明導電膜16をスパッタリングによって形成する。スパッタ室95内には、たとえば、直流スパッタリング装置が設けられている。なお、直流スパッタリング装置は周知であり、詳細説明を省略する。

【0061】基板搬出室96は、透明導電膜16が形成された後の基板1を電極形成部90から搬出するための真空室である。治具/マスク搬出室97は、基板1から分離された後の成膜用マスク200および結合治具100を電極形成部90から搬出するための真空室である。

【0062】搬送作業室92内には、上記構成の搬送ロボット45が設置されている。この搬送ロボット45に 40 より、基板1、成膜用マスク200および結合治具10 0の搬送が行われる。

【0063】次に、上記した成膜装置40を用いた成膜方法について説明する。まず、基板搬入室57に図5に示した状態の基板1を必要枚数だけ搬入しておく。また、マスク搬入室53にも必要枚数の成膜用マスク200を搬入しておく。さらに、治具搬入室57にも必要枚数の結合治具100を搬入しておく。

【0064】一方、各有機層形成部60,70および8 0の各蒸着処理室の加熱容器420を加熱し、蒸着材料 50 Vsが一定の蒸発レートで蒸発するように蒸着材料Vs

20

40

16

の温度をコントロールしておく。なお、加熱容器 4 2 0 は、シャッタ 4 4 0 によって閉じた状態としておく。なお、各蒸着処理室における蒸発レートは、最も厚い層を成膜する蒸着処理室における成膜時間に合わせてコントロールすることが好ましい。すなわち、有機層形成工程におけるタクトタイムは、最も厚い層を成膜するのに要する時間に依存するからである。

【0065】次に、基板搬入室57のゲートバルブを開いて、基板搬入室57内の基板1を搬送ロボット45により前処理室52に搬入する。前処理室52において、基板1に、たとえば、400sccm、高周波パワー50W,処理時間120秒の条件下で酸素プラズマ処理を施す。

【0066】一方、この酸素プラズマ処理が完了する前に、治具搬入室57にある結合治具100を、図9に示すように、搬送ロボット45の保持部45dにより保持し、アライメント室54に搬入する。図9において、ゲートgtを通じてアライメント室54に搬入された結合治具100の把手部102は、治具ホルダ310の保持部310aによって保持可能な位置に位置決めされる。さらに、図10に示すように、治具ホルダ310を昇降機構330によって所定の位置まで上昇させる。治具ホルダ310の上昇によって、結合治具100は搬送ロボット45の保持部45dから離れ、結合治具100が治具ホルダ310により保持される。

【0067】また、搬送ロボット45は、結合治具100のアライメント室54への搬送完了後に、図10に示すように、マスク搬入室53にある成膜用マスク200をアライメント室54に搬入する。成膜用マスク200の搬入位置は、結合治具100とマスクホルダ320と30の間である。

【0068】この状態から、図11に示すように、マスクホルダ320を昇降機構350によって所定位置まで上昇させる。マスクホルダ320の上昇により、成膜用マスク200は搬送ロボット45の保持部45dから離れ、マスクホルダ320によて保持される。

【0069】次いで、結合治具100が治具ホルダ310により保持され、成膜用マスク200がマスクホルダ320によって保持された状態で、前処理室52において表面処理が完了した基板1を、図12に示すように、搬送ロボット45によりアライメント室54に搬入する。図12に示すように、基板1をアライメント室54に搬入する前に、マスクホルダ320を所定の位置まで下降させ、結合治具100と成膜用マスク200との間に基板1が干渉しないスペースを形成しておく。

【0070】次いで、図13に示すように、基板ホルダ314を移動回転機構340によって所定の位置まで上昇させる。基板ホルダ314の上昇によって、基板1は搬送ロボット45の保持部45dから離れ、基板1は支持部316によって保持される。これにより、結合治具50

100が治具ホルダ310により保持され、成膜用マスク200がマスクホルダ320によって保持され、基板1が基板ホルダ314によって保持された状態となる。

【0071】次いで、上記の状態から移動回転機構340によって基板1の θ 方向の回転位置およびX、Y方向の位置を調整し、基板1と成膜用マスク200とのアライメントを行う。このアライメント作業は、たとえば、図示しない撮像装置で撮像した成膜用マスク200および基板1の画像から画像処理により得た成膜用マスク200に対する基板1の位置および姿勢情報に基づいて行われる。また、図14に示すように、これから基板1に形成する有機層11Gの形成位置に成膜用マスク200の開口200hが位置するようにアライメントを行う。

【0072】基板1と成膜用マスク200とのアライメント作業が完了したのち、図15に示すように、マスクホルダ320を所定の位置まで上昇させ、基板1と成膜用マスク200とを接触させ、基板1が成膜用マスク200上に載置された状態にする。

【0073】この状態から、図16に示すように、マスクホルダ320をさらに上昇させ、基板1と結合治具100をを接触させる。これにより、結合治具100のマグネットプレート101の磁力により、成膜用マスク200がマグネットプレート101に吸着され、成膜用マスク200と基板1とが結合し、アライメントされた状態が維持される。また、成膜用マスク200および基板1の結合によって、図14に示したように、成膜用マスク200はリブ14の頂部に当接し、成膜用マスク200とアノード電極10との距離が一定に保たれる。

【0074】次いで、図16に示すように、結合状態にある結合治具100、基板1および成膜用マスク200がマスクホルダ320に保持された状態で、搬送ロボット45の保持部45dを成膜用マスク200の下方に挿入する。さらに、マスクホルダ320を下降させることにより、結合状態にある結合治具100、基板1および成膜用マスク200が治具ホルダ310を所定位置まで下降させることにより、結合状態にある結合治具100、基板1および成膜用マスク200が搬送ロボット45の保持部45dに置かれる。

【0075】次いで、搬送ロボット45の保持部45d に置かれた結合状態にある結合治具100、基板1およ び成膜用マスク200を搬送室56に搬送する。

【0076】次いで、搬送室56に搬送された結合状態にある結合治具100、基板1および成膜用マスク200を搬送作業室61に設置された搬送ロボット45によって蒸着処理室62に搬入する。

【0077】図17に示すように、ゲートg t を通じて 蒸着処理室62の隔壁400内に搬入された結合状態に ある結合治具100、基板1および成膜用マスク200 は、搬送ロボット45の保持部45dを所定位置まで下

降させることにより、治具ホルダ401によって保持さ れる。

【0078】基板1および成膜用マスク200が治具ホ ルダ401によって保持されたのち、図18に示すよう に、治具ホルダ401を所定の回転数で回転させるとと もに、シャッタ440を開き蒸着を行い、有機層11G の正孔注入層11aを所定の厚さに形成する。正孔注入 層11aの成膜に要する時間は、蒸着レートによって決 まる。また、基板1および成膜用マスク200を回転さ せることにより、正孔注入層11 aが均一な厚さで形成 10 される。

【0079】有機層11Gの正孔注入層11aの形成 後、上記と同様な手順により、結合状態にある結合治具 100、基板1および成膜用マスク200を搬送作業室 61に設置された搬送ロボット45によって蒸着処理室 63に搬入し、有機層11Gの正孔輸送層11bを形成 する。同様に、有機層11Gの発光層11cの形成を蒸 着処理室64において行う。この結果、基板1のアノー ド電極10上に積層された正孔注入層11a、正孔輸送 層11bおよび発光層11cからなる有機層11Gが形 20 成される。

【0080】次いで、有機層11Gが形成された基板1 を成膜用マスク200と結合された状態で赤有機層形成 部70のアライメント室71に搬送する。図19に示す ように、結合治具100によって結合された基板1およ び成膜用マスク200がアライメント室71へ搬送ロボ ット45の保持部45dによって搬入されたのち、マス クホルダ320を所定の位置まで上昇させ、保持部45 dから成膜用マスク200を離隔させ、マスクホルダ3 20によって保持する。

【0081】次いで、図20に示すように、治具ホルダ 310を所定位置まで上昇させる。この治具ホルダ31 0の上昇により、結合治具100のみが基板1および成 膜用マスク200から分離される。結合治具100のみ が基板1および成膜用マスク200から分離された状態 から、基板ホルダ314を所定位置まで上昇させる。基 板ホルダ314の上昇により、基板1と成膜用マスク2 00とが離隔する。これにより、結合治具100が治具 ホルダ310により保持され、成膜用マスク200がマ スクホルダ320によって保持され、基板1が基板ホル 40 グネシウムと銀との成膜速度に比は、たとえば、9:1 ダ314によって保持された状態となる。

【0082】この状態から、図15および図16を参照 して説明した動作と同様に、基板1と成膜用マスク20 0とを再びアライメントする。アライメント室71にお いては、図21に示すように、これから基板1に形成す る有機層11Rの形成位置に成膜用マスク200の開口 200hが位置するようにアライメントを行う。

【0083】アライメントの完了後、図15および図1 6を参照して説明した動作と同様に、基板1と成膜用マ スク200とを結合治具100で再び結合し、基板1と 50 成膜用マスク200とが結合された状態で蒸着処理室7 3、74および75に順次搬送して、有機層11Rの正 孔注入層11a、正孔輸送層11bおよび発光層11c を形成する。

【0084】有機層11Rの形成後、結合された状態の 基板1および成膜用マスク200をアライメント室81 に搬入し、アライメント室71における動作と同様に、 基板1と成膜用マスク200とのアライメントおよび結 合治具100による結合を再び行う。アライメント室8 1においては、図21に示すように、これから基板1に 形成する有機層11Bの形成位置に成膜用マスク200 の開口200hが位置するようにアライメントを行う。 アライメントの完了後、図15および図16を参照して 説明した動作と同様に、基板1と成膜用マスク200と を結合治具100で再び結合し、基板1と成膜用マスク 200とが結合された状態で蒸着処理室83、84およ び85に順次搬送して、有機層11Bの正孔注入層11 a、正孔輸送層11bおよび発光層11cを形成する。 【0085】有機層11Bの形成後、結合治具100に より結合状態にある基板1および成膜用マスク200を 電極形成部90に搬送する。電極形成部90において、 結合状態にある基板1および成膜用マスク200を最初 に基板/マスク分離室93に搬入する。

【0086】基板/マスク分離室93においては、結合 治具100により結合状態にある基板1および成膜用マ スク200を分離する。なお、基板/マスク分離室93 はアライメント室81等と同様のアライメント機構を備 えており、このアライメント機構を所定の手順で動作さ せることにより、結合治具100と基板1と成膜用マス ク200とを分離することができる。

【0087】基板1および成膜用マスク200を分離し たのち、基板1を電極形成室94に搬送し、結合治具1 00および成膜用マスク200を治具/マスク搬出室9 7に搬入する。

【0088】電極形成室94では、カソード電極12を 蒸着によって形成する。具体的には、たとえば、マグネ シウム (Mg) と銀(Ag) とを共蒸着することによ り、Mg-Ag合金からなるカソード電極12を形成す る。膜厚は、たとえば、10nm程度である。また、マ とする。

【0089】次いで、基板1の有機層11G, 11R, 11B上にカソード電極12を形成後、基板1をスパッ 夕室95に搬入し、カソード電極12上に透明導電膜1 6を形成する。透明導電膜16の成膜条件は、たとえ ば、スパッタガスとしてアルゴン(Ar)と酸素(O ,) の混合ガス (体積比Ar/O, =1000) を用 い、圧力を約0.3Paとし、直流スパッタリング装置 の出力を40Wとする。

【0090】次いで、透明導電膜16を形成後、基板1

を基板搬出室96に搬送する。基板搬出室96に搬送された基板1は、基板搬出室96から搬出されたのち、紫外線硬化樹脂層17を介して基板18が固着される。これにより、有機EL表示装置の組立が完了する。

【0091】また、基板/マスク分離室93において分離された成膜用マスク200および結合治具100を治具/マスク搬出室97に搬送する。治具/マスク搬出室97に搬送された成膜用マスク200および結合治具100は、治具/マスク搬出室97から搬出されたのち、再び使用される。なお、成膜用マスク200を再び使用する前に欠陥がないかを検査することにより、欠陥の存在する成膜用マスク200の再使用を回避でき、不良品の有機EL表示装置が製造されるのを未然に防ぐことができる。

【0092】以上のように、本実施形態によれば、複数の有機材料層からなる有機層11G,11R,11Bの各有機材料層を異なる蒸着処理室において分担して行うことにより、蒸着に用いる有機材料の無駄な消費を抑制することができる。また、本実施形態によれば、基板1と成膜用マスク200とをアライメントし、かつ、結合20した状態で搬送し複数の有機材料層の成膜を連続的に行うため、各蒸着処理室においてアライメントのための時間が不要となり、タクトタイムを短縮することができる。また、本実施形態によれば、各蒸着処理室にアライメント機構が必要なく、設備コストを低減することが可能になる。また、本実施形態によれば、基板1毎に成膜用マスク200を使用するため、仕様の異なる有機EL表示装置を同一ラインで製造することが可能となる。

【0093】本発明は上述した実施形態に限定されな い。上述した実施形態では、蒸着処理室に単一の蒸着源 30 を設け、ひとつの蒸着処理室において一つの有機材料層 のみを形成する構成としたが、蒸着処理室に複数の蒸着 源を設け、ひとつの蒸着処理室において複数の有機材料 層を形成する構成とすることも可能である。たとえば、 成膜時間が非常に長い有機材料層が存在する場合に、こ の有機材料層には単一の蒸着源を設けてこの成膜時間が 長い有機材料層のみを形成し、他の有機材料層に複数の 蒸着源を設け成膜時間が短い有機材料層を複数形成する 構成とすることにより、タクトタイムが長くなるのを防 ぐことができる。また、上述した実施形態では、有機層 40 は、3層の有機材料層を積層した場合について説明した が、さらに多くの有機材料層を積層した有機層に本発明 を適用することにより、生産性および有機材料の消費量 の観点からさらに大きな効果が得られる。また、上述し た実施形態において各室における作業が他の室における 作業に影響を及ぼさない場合においては、各室間をゲー トgtによって隔てる必要はない。また、各室の配置は 図4に示したようなクラスター状配置に限られるもので はなく、作業の順に従って直線状配置あるいはU字状配 置その他好適な配置を選択できる。

[0094]

【発明の効果】本発明によれば、有機EL表示装置の有機層の形成工程のタクトタイムを短縮することができ、有機EL表示装置の量産化が可能となる。また、本発明によれば、有機層の形成に用いられる有機材料の無駄な消費を抑制することができ、有機EL表示装置の製造コストを低減することができる。

【図面の簡単な説明】

00は、治具/マスク搬出室97から搬出されたのち、 【図1】本発明が適用される有機EL表示装置の一例を再び使用される。なお、成膜用マスク200を再び使用 10 示す図であって、当該有機EL表示装置の表示エリアのする前に欠陥がないかを検査することにより、欠陥の存 概略構成を示す要部断面図である。

【図2】本発明が適用される有機EL表示装置の一例を示す図であって、当該有機EL表示装置の表示エリアの概略構成を示す要部平面図である。

【図3】有機層11G、11R, 11Bの構造の一例を示す断面図である。

【図4】本発明の一実施形態に係る成膜装置の構成を示す図である。

【図5】有機層を形成前の基板の構成を示す断面図である。

【図6】成膜用マスクおよびこの成膜用マスクと基板1 とを結合させる結合治具の構造の一例を示す斜視図であ

【図7】アライメント室の構造を示す図である。

【図8】蒸着処理室の構成の一例を示す断面図である。

【図9】アライメント室54におけるアライメント機構の動作手順の一例を説明するための図である。

【図10】図9に続くアライメント機構の動作手順を説明するための図である。

3 【図11】図10に続くアライメント機構の動作手順を 説明するための図である。

【図12】図11に続くアライメント機構の動作手順を 説明するための図である。

【図13】図12に続くアライメント機構の動作手順を説明するための図である。

【図14】基板1の有機層11Gの形成位置に成膜用マスク200をアライメントした状態を示す図である。

【図15】図13に続くアライメント機構の動作手順を 説明するための図である。

0 【図16】図15に続くアライメント機構の動作手順を 説明するための図である。

【図17】結合状態にある基板1と成膜用マスク200 を蒸着処理室に搬入した状態を説明するための図であ ス

【図18】蒸着処理室において蒸着を行っている状態を 説明するための図である。

【図19】アライメント室71におけるアライメント機構の動作手順の一例を説明するための図である。

【図20】図19に続くアライメント機構の動作手順を 50 説明するための図である。

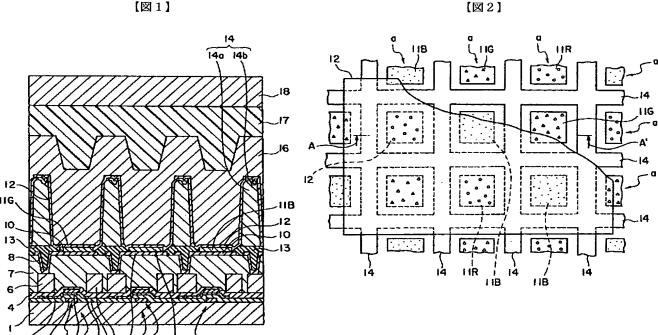
【図21】基板1の有機層11Rの形成位置に成膜用マ スク200をアライメントした状態を示す図である。

【図22】基板1の有機層11Bの形成位置に成膜用マ スク200をアライメントした状態を示す図である。 【符号の説明】

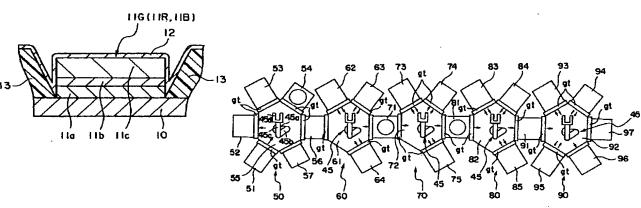
1…基板, 40…成膜装置、45…搬送ロボット、50 …搬入部、51…基板搬入室、52…前処理室、53… マスク搬入室、54…アライメント室、55…搬送作業 室、56…搬送室、57…治具搬入室、60…緑有機層 形成部、61…搬送作業室、62, 63, 64…蒸着処 10 ダ、402…回転軸、430…回転機構、420…加熱 理室、70…赤有機層形成部、71…アライメント室、

72…搬送作業室、73,74,75…蒸着処理室、8 0…青有機層形成部、81…アライメント室、82…搬 送作業室、83,84,85…蒸着処理室、90…電極 形成部、91…搬入室、92…搬送作業室、93…基板 /マスク分離室、94…電極形成室、95…スパッタ 室、96…基板搬出室、97…治具/マスク搬出室、1 00…結合治具、200…成膜用マスク200、300 …隔壁、310…治具ホルダ、314…基板ホルダ、3 20…マスクホルダ、400…隔壁、401…治具ホル 容器、 V s …蒸着材料。

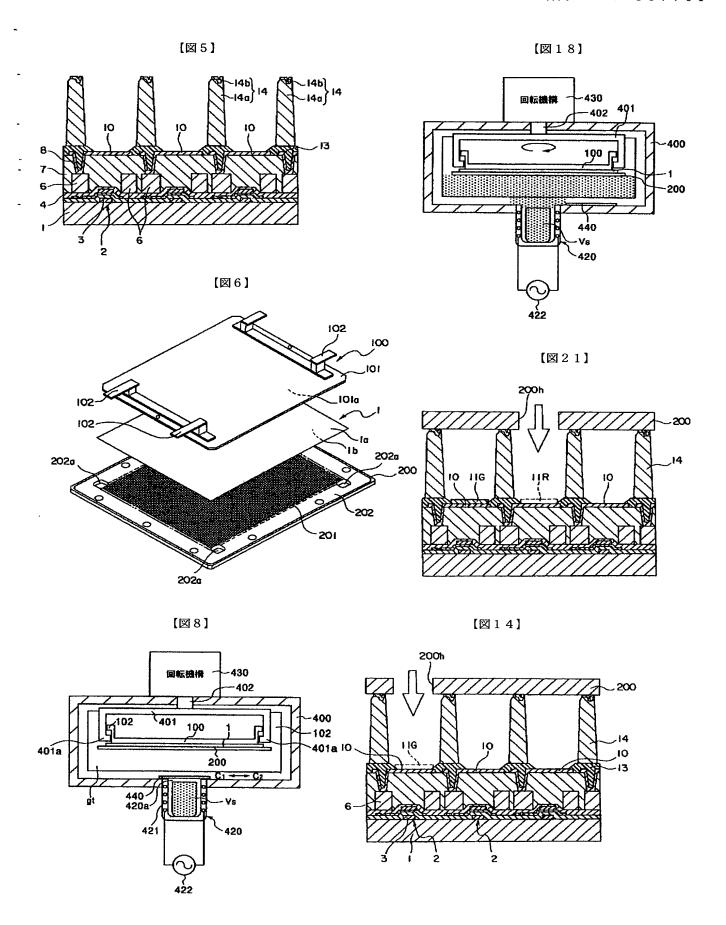
【図1】

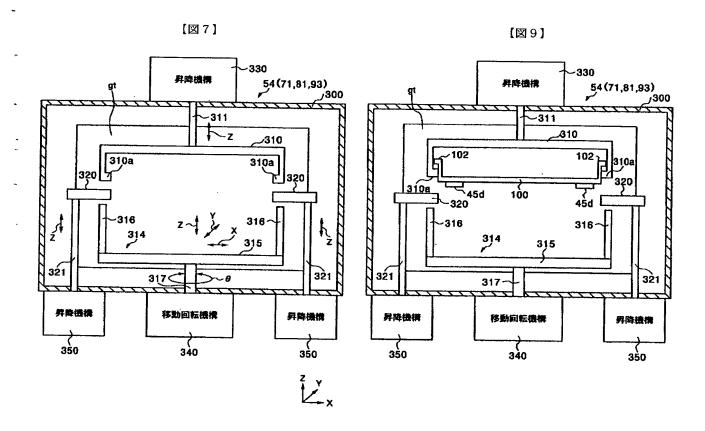


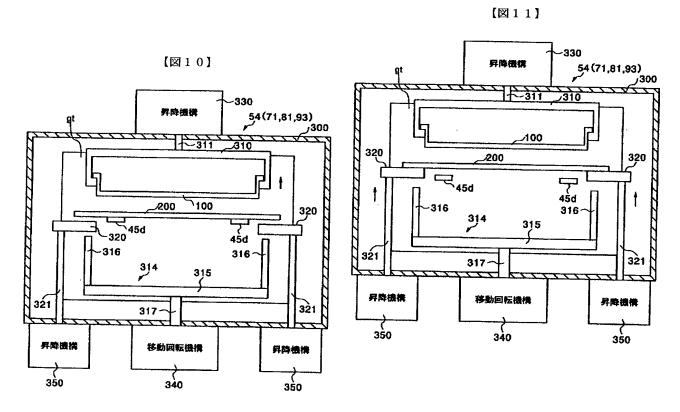
[図3]

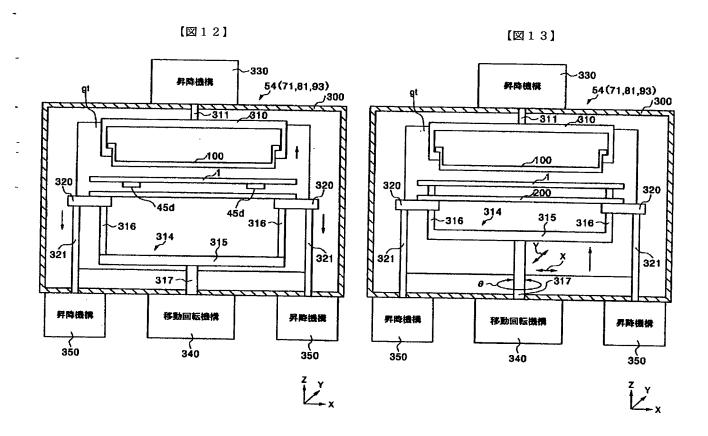


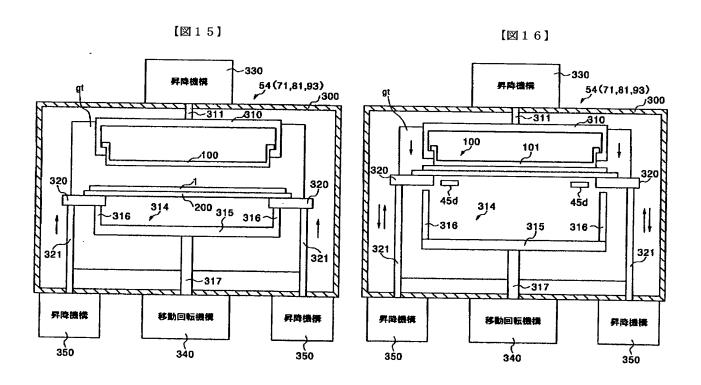
[図4]











【図17】 [図19] 430 回転機構 54 (71,81,93) 402 400 102 401a 200 1350 320 45d 45d 316 420 321 321 -317 昇降機構 移動回転機構 昇降機構 350 340 350 【図20】 【図22】 54 (71,81,93) 320 314 316 316 315 321 321

【手続補正書】

昇降機構

350

【提出日】平成14年3月25日(2002.3.2 5)

-317

昇降機構

350

移動回転機構

340

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】正孔注入層11a、正孔輸送層11bおよび発光層11cは、それぞれ発光色に応じた有機材料を蒸着によって所定の膜厚に形成される。正孔注入層11

テーマコート'(参考)

В

Α

Z

aの有機材料としては、たとえば、m-MTDATA [4,4,4-tris(3-methylphenylphenylamino) triphenylamine] 等が用いられる。正孔注入層11aの厚さは、たとえば、30nm程度である。正孔輸送層11bの有機材料としては、たとえば、α-NPD[4,4-bis(N-1-naphthyl-N-phenylamino)biphenyl] 等が用いられる。正孔輸送層11bの厚さは、たとえば、20nm程度である。発光層11cの有機材料としては、たとえば、Alq3 [tris(8-quinolinolato)aluminium(III)] 等が用いられる。発光層11cの厚さは、たとえば、50nm程度である。発光層11cの厚さは、たとえば、50nm程度である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】 0088 【補正方法】変更 【補正内容】

【0088】電極形成室94では、カソード電極12を蒸着によって形成する。具体的には、たとえば、マグネシウム (Mg) と銀 (Ag) とを共蒸着することにより、Mg-Ag合金からなるカソード電極12を形成する。膜厚は、たとえば、10nm程度である。また、マグネシウムと銀との成膜速度の比は、たとえば、9:1とする。

フロントページの続き

(51) Int.C1.⁷ 識別記号 F I H 0 5 B 33/12 H 0 5 B 33/12 33/14 33/22 33/14 33/22

(72)発明者 紙山 功 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内 F 夕一ム(参考) 3K007 AB04 AB18 BA06 CB01 CB03 DA01 DB03 EB00 FA01 4K029 AA09 BA62 BB02 BC07 CA01 HA01 HA02 HA03 5C094 AA08 AA43 AA48 BA03 BA12 BA27 CA19 CA24 DA13 DB01 DB04 EA04 EA05 EA07 EB02

5G435 AA04 AA17 BB05 CC09 CC12 EE37 KK05 KK10

FA01 FA02 FB01 FB20 GB10